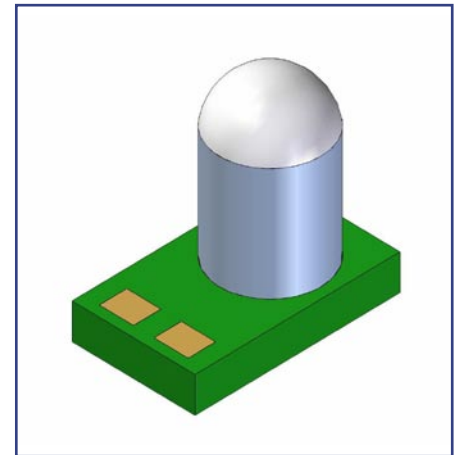


Si-PIN-Fotodiode Typ FD-30



MERKMALE

- ▶ Erhöhte Empfindlichkeit
- ▶ Integrierte, abgestimmte Hochleistungsoptik
- ▶ Keine zusätzlichen Linsen erforderlich
- ▶ Extrem kleine Empfangs- und Schielwinkel
- ▶ 3mm-Bauform, Metallgehäuse
- ▶ Löt pads für Kabelanschluss



ANWENDUNG

- ▶ Für optische Sensoren

▶ **GRENZWERTE**

Parameter	Testbedingung	typ. Werte	Einheit
Betriebstemperatur (T_{Op})		-20 / + 70	°C
Sperrspannung (V_R)		> 50	V

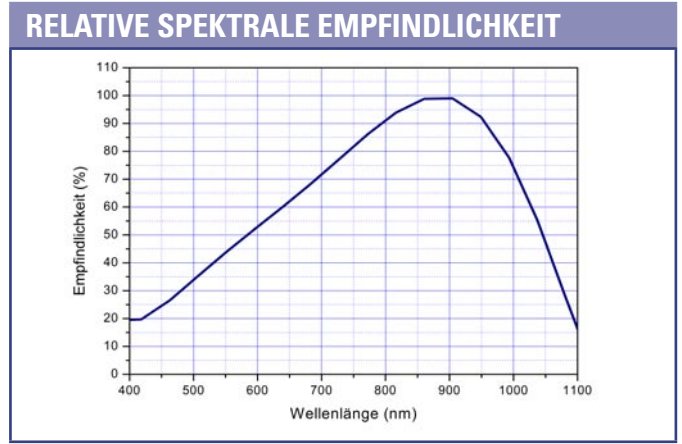
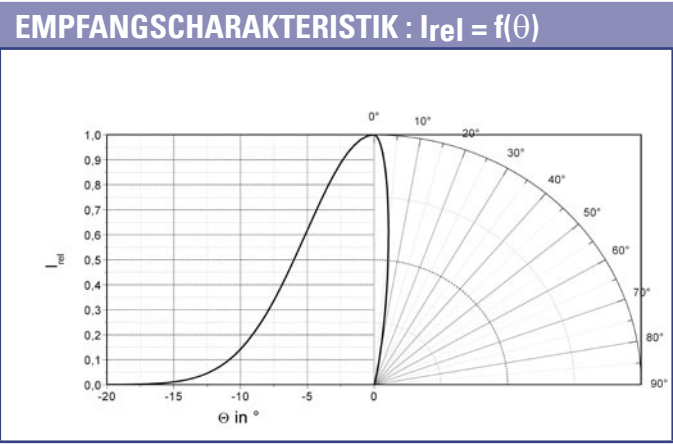
▶ **OPTISCHE UND ELEKTRONISCHE KENNWERTE (bei T=25°C)**

Parameter	Testbedingung	typ. Werte	Einheit
Chipgröße		0,76 x 0,76	mm x mm
Chipdicke		0,24	mm
Bestrahlungsempfindliche Fläche		0,55 x 0,55	mm x mm
Spektrale Fotoempfindlichkeit	650nm 875nm 940nm	0,26 0,44 0,35	A / W
Halbwinkel (θ)		6	Grad
Dunkelstrom	$V_R = 15V$	< 4 (Typ. 0,2)	nA
Anstiegs – und Abfallzeit des Fotostromes	$V_R = 20 V$, $\lambda = 860nm$, $R = 50 \Omega$	10	ns
Grenzfrequenz (-3dB)	$V_R = 20 V$, $\lambda = 860nm$, $R = 50 \Omega$	35	MHz
Rausschäquivalente Strahlungsleistung (Noise equivalent power)	$V_R = 0 V$ $\lambda = 900nm$	6×10^{-15}	$\frac{W}{\sqrt{Hz}}$
Kapazität	$V_R = 15 V$	0,6	pF

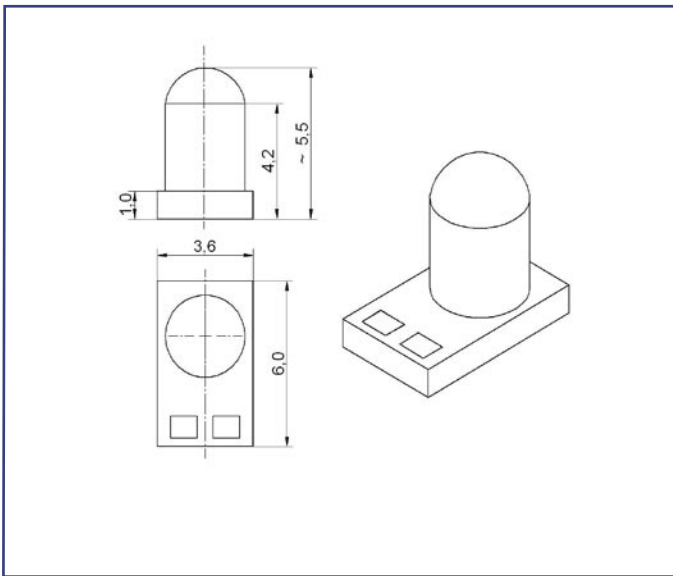


Si-PIN-Fotodiode Typ FD-30

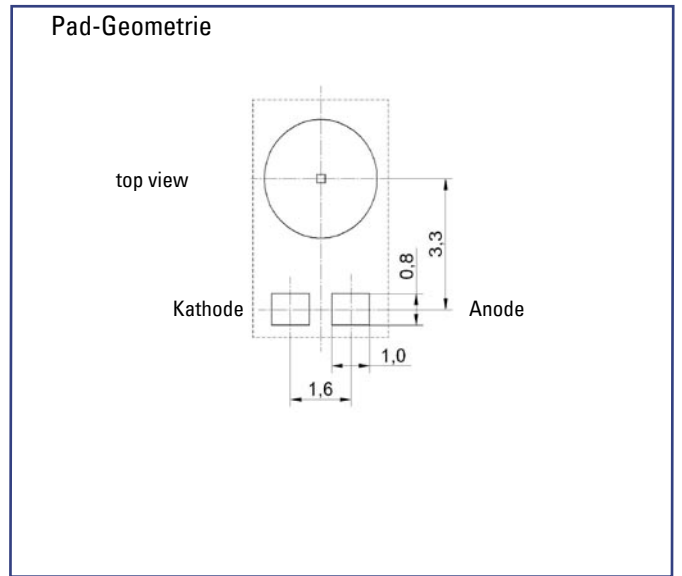
▶ **DIAGRAMME**



▶ **ABMESSUNGEN GEHÄUSE**



▶ **ANSCHLÜSSE**



BESTELLBEZEICHNUNG

OE-FD-30-VA1-SL10-9-0119